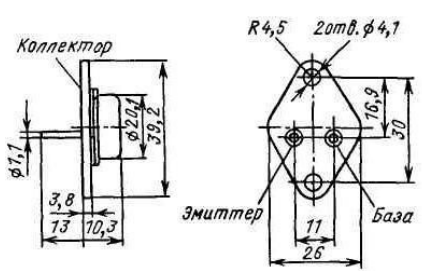


**2Т826А, 2Т826Б, 2Т826В, КТ826А, КТ826Б, КТ826В**

Транзисторы кремниевые меза-планарные *n-p-n* переключабельные высоковольтные низкочастотные мощные.  
 Предназначены для работы в схемах преобразователей постоянного напряжения, высоковольтных стабилизаторах, ключевых схемах.  
 Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.  
 Масса транзистора не более 17 г.



**Электрические параметры**

Граничное напряжение при $I_K = 100$ мА не менее:	
2Т826А, 2Т826В, КТ826А, КТ826В	500 В
2Т826Б, КТ826Б	600 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,2$ А не более	2,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,2$ А не более	2 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 0,1$ А:	
при $T_K = 298$ К	10–120
при $T_K = 398$ К 2Т826А, 2Т826Б, 2Т826В	5–300

$T_K = 373$ К, КТ826А, КТ826Б, КТ826В	5–300
при $T = 213$ К	5–120
Время спада при $U_{КЭ} = 500$ В, $U_{БЭ} = 5$ В, $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,2$ А не более.	
2Т826А, КТ826А	1,5 мкс
2Т826Б, КТ826Б	0,7 мкс
Модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $f = 1$ МГц, $U_{КЭ} = 15$ В, $I_K = 0,1$ А не менее	6
Емкость коллекторного перехода * при $U_{КБ} = 100$ В, $f =$ МГц не более	25 пФ
типичное значение	20 пФ
Емкость эмиттерного перехода* при $U_{БЭ} = 5$ В, $f = 1$ МГц не более	250 пФ
типичное значение	200 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ Ом не более:	
при $T_K = 298$ К, $U_{КЭ} = 700$ В	2 мА
при $T_K = 398$ К, $U_{КЭ} = 300$ В 2Т826А, 2Т826Б, 2Т826В	5 мА
при $T_K = 373$ К, $U_{КЭ} = 300$ В КТ826А, КТ826Б, КТ826В	5 мкА
при $T = 213$ К, $U_{КЭ} = 500$ В	4 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В не более	3 мА

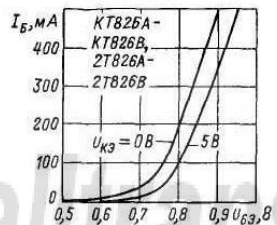
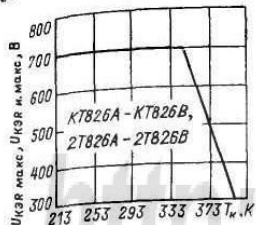
**Предельные эксплуатационные данные**

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 10$ Ом, $T_K = 213 \div 348$ К	700 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 10$ Ом, $\tau_n \leq 20$ мс, $Q \geq 50$ :	
при $\tau_{ф} > 0,2$ (скорость нарастания переднего фронта не более 3,5 В/нс), $T_K = 213 \div 348$ К	700 В
при $\tau_{ф} > 1,5$ мкс (скорость нарастания переднего фронта не более 0,66 В/нс), $T_K = 298$ К КТ826Б	1000 В
Постоянный и импульсный токи коллектора	1 А
Постоянный и импульсный токи базы	0,75 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K \leq 323$ К	15 Вт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды:	
2Т826А, 2Т826Б, 2Т826В	От 213 до $T_K = 398$ К
КТ826А, КТ826Б, КТ826В	От 213 до $T_K = 373$ К

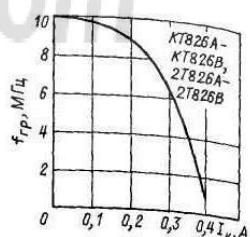
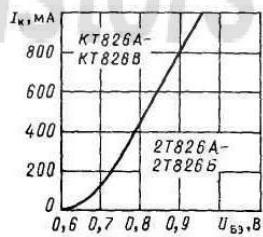
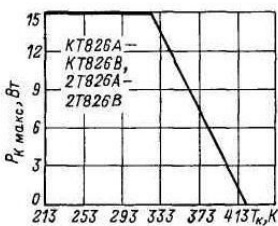
Примечания 1 Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт, при  $T_K > 323$  К рассчитывается по формуле

$$P_{K \text{ макс}} = (423 - T_K) / 6,6.$$

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от основания корпуса.



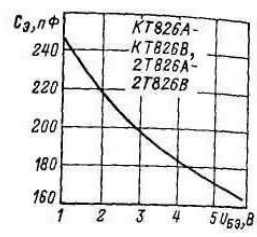
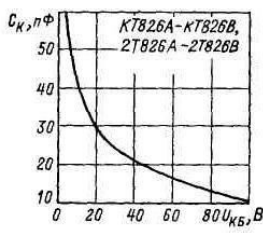
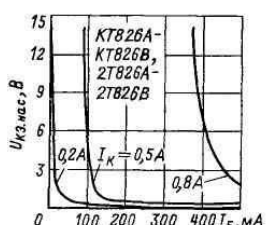
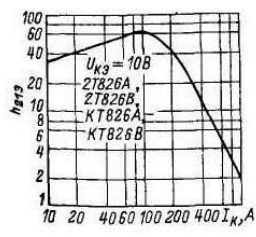
Зависимость максимально допустимого постоянного и импульсного напряжений коллектор-эмиттер от температуры корпуса.



Зависимость тока коллектора от напряжения база-эмиттер.

Зависимость граничной частоты от тока коллектора.

Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.

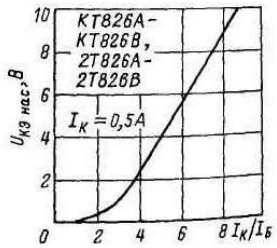
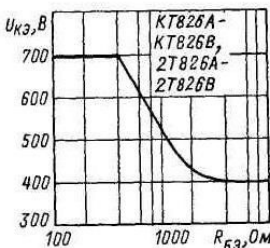
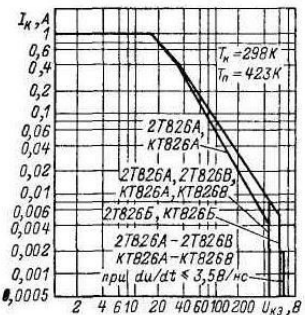
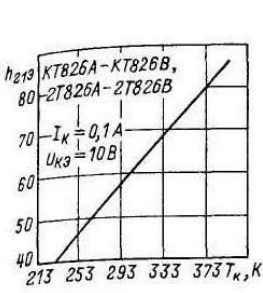


Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы.

Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база

Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения база-эмиттер



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса.

Область максимальных режимов.

Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер.

Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от  $I_K/I_B$ .